



一种SiC基的新型纳米碳复合材料的制备方法

文献类型: 专利

作者 包信和; 李星运; 周永华; 潘秀莲

发表日期 2014

专利国别 CN

专利号 CN201210181890.1

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 本发明公开了一种新型高比表面积SiC基的新型纳米碳复合材料制备方法。通过选择合成温度、气氛、不同催化剂, 可实现在SiC表面控制生长出一层或多层不同厚度的碳层, 且该碳层的形貌和结构特点随合成条件不同而不同。本发明实现了基于SiC的C-SiC复合材料的合成, 该复合材料同时具有碳材料与SiC的优势, 可应用于催化和吸附中。

公开日期 2013-12-18

申请日期 2012-06-04

语种 中文

专利申请号 CN201210181890.1

源URL [http://159.226.238.44/handle/321008/120779]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 包信和,李星运,周永华,等. 一种SiC基的新型纳米碳复合材料的制备方法, 一种SiC基的新型纳米碳复合材料的制备方法.

GB/T 7714 包信和,李星运,周永华,等. 一种SiC基的新型纳米碳复合材料的制备方法, 一种SiC基的新型纳米碳复合材料的制备方法. CN201210181890.1. 2014-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [大连化学物理研究所](#)

浏览	下载	收藏
130	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。